⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—141527

6) Int. Cl. ³ [C 07 C 25/22		識別記号	庁内整理番号 72484H		4	③公開 昭和59年(1984)8月14日		
C 09 K #G 02 F G 09 F	43/192 3/34 1/13 9/00	102	7419—4H 7229—4H 7448—2H			発明の数 2 審査請求 未請求 (全 3 頁)		
❷部分還元されたナフタリン誘導体			明	者	磯山豊志郎 #5-15-2-17-2-17-2-17-2-17-2-17-2-17-2-17-			
②特	顧 昭581	15248		明	者	横浜市金沢区乙舳町10番3号 濁川和則		

藤沢市藤沢2493番地の10 ⑫発 明 者 小島哲彦

20出

個発

横浜市金沢区乙舳町10番3号

横浜市金沢区乙舳町10番3号

⑦出 願 人 チッソ株式会社大阪市北区中之島3丁目6番32

砂代 理 人 弁理士 佐々井弥太郎 外1名

卵 細 4

願 昭58(1983)2月1日

杉森滋

1 発明の名称

部分激元されたナフタリン**跨導体** 名特許譲求の範囲

(1) 一般武

(上式中Rは水泉原子又は炭素数1~10の アルキル在又はアルコキン器を示し、又はア 又は00を示す)

で 扱わされる 2 - 俊侠 - 6 - (4 - ハロゲノ フエニル)オクタヒドロナフタリン。

(2) — 股 式

(上式中R は水素原子又は炭素数 1 ~ 1 0 の アルギルコキンボ アルギル 部を示し、又は B 又は Olを示す) で 扱わされる 2 - 量換 - 6 - (4 - ヘロゲノ フェニル) - 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 8-オクタヒ ドロナフタリンである特許請求の範囲第 1 項記載の化合物。

(3) 一般式

(上式中 B は水溶原子又は炭素数 1 ~ 1 0 の アルキル 基又はアルコキン 基を示し、 E は B 又は C4 を示す)

て扱わされる特許請求の範囲第1項配載の2 一個換ー6ー(4ーハロゲノフエニル)ー1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 7, 8ーオクタヒドロナフタリン である特許請求の範囲第1項記載の化合物。

(4) - 数式

(上式中R は水東原子又は炭素数 1 ~ 1 0 の アルキル 基又はアルコキ シ 蓋を示し、 X は P 又は C& を 示す)

で扱わされる2ー 置換ー 6 ー(4ーハロゲノ フエニル)オタタヒドロナフタリンを少なく

待開昭59-141527(2)

とも一個含有するとどを特徴とする液晶組成物。

3.発明の詳細な説明

本発明は正の勝電異方性を有する新規被晶性物質及びそれを含有する核晶組成物に関する。

で扱わされる2一置換ー6ー(4 ーハロゲノフ エニル)オクタヒドロナフタリン及びそれを含 有する被晶組成物である。

本免明の化合物は 液晶相を示するのと示さない ものとがあるが、いずれにしてもその酸 放会物 のとがあるが、いずれにしてもその酸 合物 のとがある 2 ー ヘキンルー 6 ー (4 ー クロロフェニル)ー 1、1 a、2、3、4、4 a、5、8 ー オ クタヒドロナフタリンは 6 2.7 じから 9 3.4 じてそ 物をリンク相を示す化合物であり、とれらの化合物を用いて低電圧で駆動できる 決示 案子ができる。 又本 発明の化合物の 光学 異方性値 ム n が 小さく、その性 質を生かした 投示用セルへ 応用される。

次代本発明の化合物の製造法を示すと、既知の方法で製造した2一般換ーデカリンー6ーオンと4ーハロゲノフエニルマグネンウムプロミドと反応して2一般換ー6ー(4ーハロゲノフエニル)デカリンー6ーオールとする。2のものを破破水米カリウムを触媒として、脱水反応を行い、2一般換ー6ー(4ーハロゲノフエニ

(上式中Rは水素又は炭素数1~10のアルキル基又はアルコキン基を示し、IはF又は Cℓ のいずれかを示す)

ル) - 1,1a,2,3,4,4a,5,8 - オクタヒドロナフ
タリン及び2 - 置換 - 6 - (4 - ハロゲノフエ
ニル) - 1,1a,2,3,4,4a,7,8 - オクタヒドロナ
フタリンの混合物を得る。この混合物を再結品
して各成分を得た。

以上を化学式で示すと、

(R. Xは前配に同じ)

以下実施例により本発明を更に詳細に説明する。

寒 格 例 1

(2ープロピルー6ー(4ーフルオロフエニル)ー1,1e,2,3,4,4e,7,8ーオクタヒドロナフタリンの製造)

既知の 方法で製造した 2 - ブロビルデカリン - 2 - オン 4 2 8 をテトラヒドロフラン100 st

特開昭59-141527(3)

にとかしたものに4ーフルオロプロモベンセン 4 5.6 8 と金科マグキシウム 6.3 9 からつくつ た 4 ーフルオロフエニルマグネシウムプロミド を窓米求朗下30℃に保ちながら施下する。つ ぎにとの反応核を2時間震流した後冷却する。 3 N塩酸200mを歩つくり加える。つぎに 200世のトルエンで抽層を抽出した後、トル エン悩を洗液が中性になるまで水洗する。トル エン脳を成圧化てトルエンを貿去し、残つた抽 状物に硫酸水素カリウムツを配え、窒素採用 気下150℃、2時間加熱、脱水を行う。反応 終了後トルエン200配を加え、不酔物を护別 し、トルエン層を水で洗滌する。中性にした後、 トルエン値を放圧にて留去し、残つた抽状物を アセトンーエタノール 1:1 の 善雄 で 数回 再結 品する。とのようにして得られた化合物のNMR スペクトル及びIRスペクトルから、このもの が2ープロビルー6ー(4ーフルオロフエニル) - 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 8-オクタヒドロナフタリ ンであることが確認された。収量421,融点

又、母板より2ープロピルー6ー(4ーフルオロフエニル)-1,1a,2,3,4,4a,7,8-オクタ

ヒドロナフタリンが得られた。

4 4.0 ~ 4 4.3 C T 8 7 7 8 ...

爽筋例2,3

同様にして実施例1における2ープロビルデカリンー2ーオンの代りにそれぞれに対応する2ーアルキルデカリンー2ーオンを、又4ーフルオロブロモベンセンの代りに4ークロロブロモベンゼンを用いてつぎに示す化合物を製造した。

2 - ブロビルー 6 - (4 - クロロフエニル) - 1, 1e, 2, 3, 4, 4a, 5, B - オクタヒドロナフタリン ン 融点 8 3.0 ~ 8 3.7 t。

2 - ヘキシルー 6 - (4 - クロロフエニル)
- 1, 1s, 2, 3, 4, 4a, 5, 8 - オクタヒドロナフタリン C - N 点 6 2.7 ~ 6 3.5 C. N - I 点 93.4

実施例4(使用例)

トランスー4ープロビルー(41ーシアノフェ

ニル)シクロヘキサン 2 4 月
トランスー 4 ーベンチルー(4 ーシアノフェニル)シクロヘキサン 3 6 月
トランスー 4 ーベンチルー(4 ーシアノフェニル)シクロヘキサン 2 5 月
トランスー 4 ーベンチルー(4 ーシアノピフェニル)シクロヘキサン 1 5 月
からたる被晶組成物の N ー I 点は 7 2 ℃であり
2 0 ℃における粘度は 2 8 cp、厚さ 1 0 μm の
T N セルに對入した 6 ののしきい 値電圧は 1.7
V、飽和電圧は 2.1 V でもつた。

この 液晶組成物 9 0 部に本発明の実施例 1 で製造した 2 ープロピルー 6 ー(4 ーフルオロフエニル)ー 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 8ーオクタと ドロナフタリン 1 0 部を加えた 液晶組成物のドー I 点は 3 6.1 でとなり、 2 0 でにおける粘度は5 1 cpとなつたが、上記セルに對入したもののしきい値電圧は 1.1 V、 飽和電圧は 1.6 V と低酸することができた。